

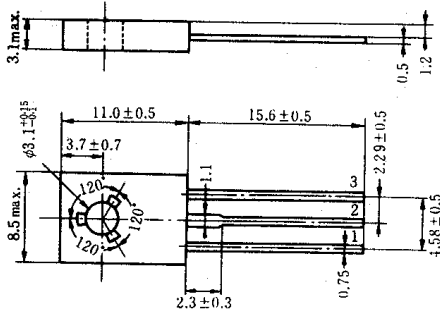
# 2SK619

## シリコン N チャンネル MOS FET

高周波増幅用  
高インピーダンス増幅用

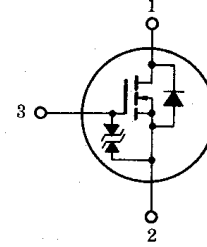
## SILICON N-CHANNEL MOS FET

HIGH FREQUENCY AMPLIFIER  
HIGH IMPEDANCE AMPLIFIER



(JEDEC TO-126 MOD.)

1. ドレイン : Drain
  2. ソース : Source
  3. ゲート : Gate
- (Dimensions in mm)

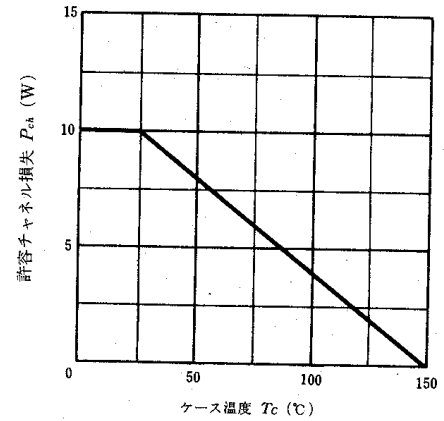


### ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SK619	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DSS}$	70	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GSS}$	$\pm 9$	V
ドレイン電流	$I_D$	0.3	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(\text{peak})}$	0.5	A
許容チャンネル損失	$P_{ch}$	1.0	W
	$P_{ch}^*$	10	W
チャンネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値  
\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

### 許容チャンネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



### ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=1\text{mA}, V_{GS}=0$	70	—	—	V
ゲート・ソース破壊電圧	$V_{(BR)GSS}$	$I_D=\pm 1\text{mA}, V_{DS}=0$	$\pm 9$	—	—	V
ドレイン電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=50\text{V}, V_{GS}=0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(\text{off})}$	$I_D=1\text{mA}, V_{DS}=20\text{V}$	0.3	—	1.8	V
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(\text{on})}$	$I_D=0.1\text{A}, V_{GS}=9\text{V}^*$	—	—	5.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=0.2\text{A}, V_{DS}=10\text{V}^*$	90	130	—	mS
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$	—	10	—	pF
出力容量	$C_{oss}$		—	6	10	pF

\* パルス測定  
\* Pulse Test